

calculatoratoz.comunitsconverters.com

CMOS-Wechselrichter Formeln

[Rechner!](#)[Beispiele!](#)[Konvertierungen!](#)

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Liste von 16 CMOS-Wechselrichter Formeln

CMOS-Wechselrichter ↗

1) Ausbreitungsverzögerung für CMOS mit Übergang von hoher zu niedriger Ausgangsleistung ↗

fx

Rechner öffnen ↗

$$\zeta_{PHL} = \left(\frac{C_{load}}{K_n \cdot (V_{DD} - V_{T,n})} \right) \cdot \left(\left(2 \cdot \frac{V_{T,n}}{V_{DD} - V_{T,n}} \right) + \ln \left(\left(4 \cdot \frac{V_{DD} - V_{T,n}}{V_{DD}} \right) - 1 \right) \right)$$

ex $0.002508\text{ns} = \left(\frac{0.93\text{fF}}{200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot (3.3\text{V} - 0.8\text{V})} \right) \cdot \left(\left(2 \cdot \frac{0.8\text{V}}{3.3\text{V} - 0.8\text{V}} \right) + \ln \left(\left(4 \cdot \frac{3.3\text{V} - 0.8\text{V}}{3.3\text{V}} \right) - 1 \right) \right)$

2) Ausbreitungsverzögerung für Übergangs-CMOS von niedriger zu hoher Ausgangsleistung ↗

fx

Rechner öffnen ↗

$$\zeta_{PLH} = \left(\frac{C_{load}}{K_p \cdot (V_{DD} - |V_{T,p}|)} \right) \cdot \left(\left(\frac{2 \cdot |V_{T,p}|}{V_{DD} - |V_{T,p}|} \right) + \ln \left(\left(4 \cdot \frac{V_{DD} - |V_{T,p}|}{V_{DD}} \right) - 1 \right) \right)$$

ex $0.006765\text{ns} = \left(\frac{0.93\text{fF}}{80\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot (3.3\text{V} - |-0.9\text{V}|)} \right) \cdot \left(\left(\frac{2 \cdot |-0.9\text{V}|}{3.3\text{V} - |-0.9\text{V}|} \right) + \ln \left(\left(4 \cdot \frac{3.3\text{V} - |-0.9\text{V}|}{3.3\text{V}} \right) - 1 \right) \right)$

3) Durchschnittliche Ausbreitungsverzögerung CMOS ↗

fx $\zeta_P = \frac{\zeta_{PHL} + \zeta_{PLH}}{2}$

Rechner öffnen ↗

ex $0.004236\text{ns} = \frac{0.00229\text{ns} + 0.006182\text{ns}}{2}$

4) Durchschnittliche Verlustleistung CMOS ↗

fx $P_{avg} = C_{load} \cdot (V_{DD})^2 \cdot f$

Rechner öffnen ↗

ex $0.404095\text{mW} = 0.93\text{fF} \cdot (3.3\text{V})^2 \cdot 39.9\text{GHz}$

5) Lastkapazität des kaskadierten Inverter-CMOS ↗

fx $C_{load} = C_{gd,p} + C_{gd,n} + C_{db,p} + C_{db,n} + C_{in} + C_g$

Rechner öffnen ↗

ex $0.93\text{fF} = 0.15\text{fF} + 0.1\text{fF} + 0.25\text{fF} + 0.2\text{fF} + 0.05\text{fF} + 0.18\text{fF}$



6) Maximale Eingangsspannung CMOS ↗

$$\text{fx } V_{IL} = \frac{2 \cdot V_{output} + (V_{T0,p}) - V_{DD} + K_r \cdot V_{T0,n}}{1 + K_r}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$\text{ex } 1.08V = \frac{2 \cdot 3.14V + (-0.7V) - 3.3V + 2.5 \cdot 0.6V}{1 + 2.5}$$

7) Maximale Eingangsspannung für symmetrisches CMOS ↗

$$\text{fx } V_{IL(\text{sym})} = \frac{3 \cdot V_{DD} + 2 \cdot V_{T0,n}}{8}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$\text{ex } 1.3875V = \frac{3 \cdot 3.3V + 2 \cdot 0.6V}{8}$$

8) Minimale Eingangsspannung CMOS ↗

$$\text{fx } V_{IH} = \frac{V_{DD} + (V_{T0,p}) + K_r \cdot (2 \cdot V_{out} + V_{T0,n})}{1 + K_r}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$\text{ex } 1.557143V = \frac{3.3V + (-0.7V) + 2.5 \cdot (2 \cdot 0.27V + 0.6V)}{1 + 2.5}$$

9) Minimale Eingangsspannung für symmetrisches CMOS ↗

$$\text{fx } V_{IH(\text{sym})} = \frac{5 \cdot V_{DD} - 2 \cdot V_{T0,n}}{8}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$\text{ex } 1.9125V = \frac{5 \cdot 3.3V - 2 \cdot 0.6V}{8}$$

10) Rauschmarge für Hochsignal-CMOS ↗

$$\text{fx } N_{MH} = V_{OH} - V_{IH}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$\text{ex } 1.8V = 3.35V - 1.55V$$

11) Schwellenspannung CMOS ↗

$$\text{fx } V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\frac{1}{K_r} \cdot (V_{DD} + (V_{T0,p}))}}{1 + \sqrt{\frac{1}{K_r}}}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

$$\text{ex } 1.374852V = \frac{0.6V + \sqrt{\frac{1}{2.5} \cdot (3.3V + (-0.7V))}}{1 + \sqrt{\frac{1}{2.5}}}$$



12) Schwingungsperiode Ringoszillator CMOS [Rechner öffnen](#)

fx $T_{osc} = 2 \cdot n \cdot \zeta_p$

ex $0.0252\text{ns} = 2 \cdot 3 \cdot 0.0042\text{ns}$

13) Transkonduktanzverhältnis CMOS [Rechner öffnen](#)

fx $K_r = \frac{K_n}{K_p}$

ex $2.5 = \frac{200\mu\text{A}/\text{V}^2}{80\mu\text{A}/\text{V}^2}$

14) Widerstandslast Maximale Eingangsspannung CMOS [Rechner öffnen](#)

fx $V_{IL(RL)} = V_{T0} + \left(\frac{1}{K_n \cdot R_L} \right)$

ex $1.4025\text{V} = 1.4\text{V} + \left(\frac{1}{200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot 2\text{M}\Omega} \right)$

15) Widerstandslast, minimale Ausgangsspannung CMOS [Rechner öffnen](#)

fx $V_{OL(RL)} = V_{DD} - V_{T0} + \left(\frac{1}{K_n \cdot R_L} \right) - \sqrt{\left(V_{DD} - V_{T0} + \left(\frac{1}{K_n \cdot R_L} \right) \right)^2 - \left(2 \cdot \frac{V_{DD}}{K_n \cdot R_L} \right)}$

ex

$$0.004341\text{V} = 3.3\text{V} - 1.4\text{V} + \left(\frac{1}{200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot 2\text{M}\Omega} \right) - \sqrt{\left(3.3\text{V} - 1.4\text{V} + \left(\frac{1}{200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot 2\text{M}\Omega} \right) \right)^2 - \left(2 \cdot \frac{3.3\text{V}}{200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot 2\text{M}\Omega} \right)}$$

16) Widerstandslast, minimale Eingangsspannung CMOS [Rechner öffnen](#)

fx $V_{IH(RL)} = V_{T0} + \sqrt{\frac{8 \cdot V_{DD}}{3 \cdot K_n \cdot R_L}} - \left(\frac{1}{K_n \cdot R_L} \right)$

ex $1.545824\text{V} = 1.4\text{V} + \sqrt{\frac{8 \cdot 3.3\text{V}}{3 \cdot 200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot 2\text{M}\Omega}} - \left(\frac{1}{200\mu\text{A}/\text{V}^2 \cdot 2\text{M}\Omega} \right)$



Verwendete Variablen

- $C_{db,n}$ NMOS-Drain-Massenkapazität (Femtofarad)
- $C_{db,p}$ PMOS-Drain-Massenkapazität (Femtofarad)
- C_g Inverter-CMOS-Gate-Kapazität (Femtofarad)
- $C_{gd,n}$ NMOS-Gate-Drain-Kapazität (Femtofarad)
- $C_{gd,p}$ PMOS-Gate-Drain-Kapazität (Femtofarad)
- C_{in} Interne Kapazität des Inverter-CMOS (Femtofarad)
- C_{load} Inverter-CMOS-Lastkapazität (Femtofarad)
- f Frequenz (Gigahertz)
- K_n Steilheit von NMOS (Mikroampere pro Quadratvolt)
- K_p Steilheit von PMOS (Mikroampere pro Quadratvolt)
- K_r Steilheitsverhältnis
- n Anzahl der Stufen Ringoszillator
- N_{MH} Rauschabstand für hohe Signale (Volt)
- P_{avg} Durchschnittliche Verlustleistung (Milliwatt)
- R_L Lastwiderstand (Megahm)
- T_{osc} Schwingungsdauer (Nanosekunde)
- V_{DD} Versorgungsspannung (Volt)
- V_{IH} Minimale Eingangsspannung (Volt)
- $V_{IH(RL)}$ Minimale Eingangsspannung der ohmschen Last (Volt)
- $V_{IH(sym)}$ Minimale Eingangsspannung Symmetrisches CMOS (Volt)
- V_{IL} Maximale Eingangsspannung CMOS (Volt)
- $V_{IL(RL)}$ Ohmsche Last Maximale Eingangsspannung CMOS (Volt)
- $V_{IL(sym)}$ Maximale Eingangsspannung Symmetrisches CMOS (Volt)
- V_{OH} Maximale Ausgangsspannung (Volt)
- $V_{OL(RL)}$ Ohmsche Last Minimale Ausgangsspannung (Volt)
- V_{out} Ausgangsspannung (Volt)
- V_{output} Ausgangsspannung für maximalen Eingang (Volt)
- $V_{T,n}$ Schwellenspannung von NMOS mit Body Bias (Volt)
- $V_{T,p}$ Schwellenspannung von PMOS mit Body Bias (Volt)
- V_{T0} Null-Bias-Schwellenspannung (Volt)
- $V_{T0,n}$ Schwellenspannung von NMOS ohne Body-Bias (Volt)
- $V_{T0,p}$ Schwellenspannung von PMOS ohne Body Bias (Volt)



- V_{th} Grenzspannung (Volt)
- ζ_P Durchschnittliche Ausbreitungsverzögerung (Nanosekunde)
- ζ_{PHL} Zeit für den Übergang der Ausgabe von hoch nach niedrig (Nanosekunde)
- ζ_{PLH} Zeit für den Übergang der Ausgabe von niedrig nach hoch (Nanosekunde)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Funktion:** **abs**, abs(Number)

Der Absolutwert einer Zahl ist ihr Abstand vom Nullpunkt auf der Zahlengeraden. Es ist immer ein positiver Wert, da er die Größe einer Zahl darstellt, ohne deren Richtung zu berücksichtigen.

- **Funktion:** **ln**, ln(Number)

Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.

- **Funktion:** **sqrt**, sqrt(Number)

Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.

- **Messung:** **Zeit** in Nanosekunde (ns)

Zeit Einheitenumrechnung ↗

- **Messung:** **Leistung** in Milliwatt (mW)

Leistung Einheitenumrechnung ↗

- **Messung:** **Frequenz** in Gigahertz (GHz)

Frequenz Einheitenumrechnung ↗

- **Messung:** **Kapazität** in Femtofarad (fF)

Kapazität Einheitenumrechnung ↗

- **Messung:** **Elektrischer Widerstand** in Megohm ($M\Omega$)

Elektrischer Widerstand Einheitenumrechnung ↗

- **Messung:** **Elektrisches Potenzial** in Volt (V)

Elektrisches Potenzial Einheitenumrechnung ↗

- **Messung:** **Steilheitsparameter** in Mikroampere pro Quadratvolt ($\mu A/V^2$)

Steilheitsparameter Einheitenumrechnung ↗



Überprüfen Sie andere Formellisten

- [Array-Datenpfad-Subsystem Formeln](#) ↗
- [Eigenschaften der CMOS-Schaltung Formeln](#) ↗
- [CMOS-Verzögerungseigenschaften Formeln](#) ↗
- [CMOS-Designmerkmale Formeln](#) ↗
- [CMOS-Wechselrichter Formeln](#) ↗
- [CMOS-Leistungsmetriken Formeln](#) ↗
- [CMOS-Spezialsubsystem Formeln](#) ↗
- [CMOS-Zeiteigenschaften Formeln](#) ↗

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

5/27/2024 | 9:07:49 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

